

# MAGNETIC SENSOR BASED ON BALLISTIC MAGNETORESISTANCE USING A PINHOLE MULTILAYER SYSTEM

Patent Number: WO02095434  
Publication date: 2002-11-28  
Inventor(s): GARCIA GARCIA NICOLAS (ES); MUÑOZ SÁNCHEZ MANUEL (ES)  
Applicant(s): GARCIA GARCIA NICOLAS (ES); CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACION (ES); MUÑOZ SÁNCHEZ MANUEL (ES)  
Requested Patent: WO02095434  
Application Number: WO2002ES00222 20020510  
Priority Number(s): ES20010001152 20010521  
IPC Classification: G01R33/09  
EC Classification: G01R33/09; H01F10/32L  
Equivalents:  
Cited Documents: WO9747982; US6011674

## Abstract

The invention relates to method of producing magnetic sensors based on ballistic magnetoresistance using pinhole multilayer systems. The multilayers used can take the form of a combination of layers of materials having different conductive and magnetic properties. The pinholes employed for constriction purposes can be integrated into the multilayer system or incorporated later using different methods. The invention is characterised in that nanometric-sized electric contacts are produced between nanometric-sized systems: thin magnetic layers and clusters. According to the invention, BMRS sensors are provided with the necessary stability and stiffness for use in devices. Moreover, said invention can be used to produce sensors having a resistance and sensitivity desired in accordance with the application thereof.

Data supplied from the [esp@cenet](mailto:esp@cenet) database - I2

(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIÓN  
EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la Propiedad  
Intelectual  
Oficina internacional



(43) Fecha de publicación internacional  
28 de Noviembre de 2002 (28.11.2002)

PCT

(10) Número de Publicación Internacional  
WO 02/095434 A1

(51) Clasificación Internacional de Patentes<sup>7</sup>: G01R 33/09

(21) Número de la solicitud internacional: PCT/ES02/00222

(22) Fecha de presentación internacional:  
10 de Mayo de 2002 (10.05.2002)

(25) Idioma de presentación: español

(26) Idioma de publicación: español

(30) Datos relativos a la prioridad:  
200101152 21 de Mayo de 2001 (21.05.2001) ES

(71) Solicitante (para todos los Estados designados salvo US): CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS [ES/ES]; C/Serrano, 117, 28006 MADRID (ES).

(72) Inventores; e

(75) Inventores/Solicitantes (para US solamente): GARCÍA GARCÍA, Nicolas [ES/ES]; LABORATORIO DE FÍSICA DE SISTEMAS PEQUEÑOS Y NANOTECNOLOGÍA, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, C/Serrano, 144, 28006 MADRID (ES). MUÑOZ SANCHEZ, Manuel [ES/ES]; CTRO. TECNOL. FÍSICAS L. TORRES QUEVEDO, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, C/Serrano, 144, 28006 MADRID (ES).

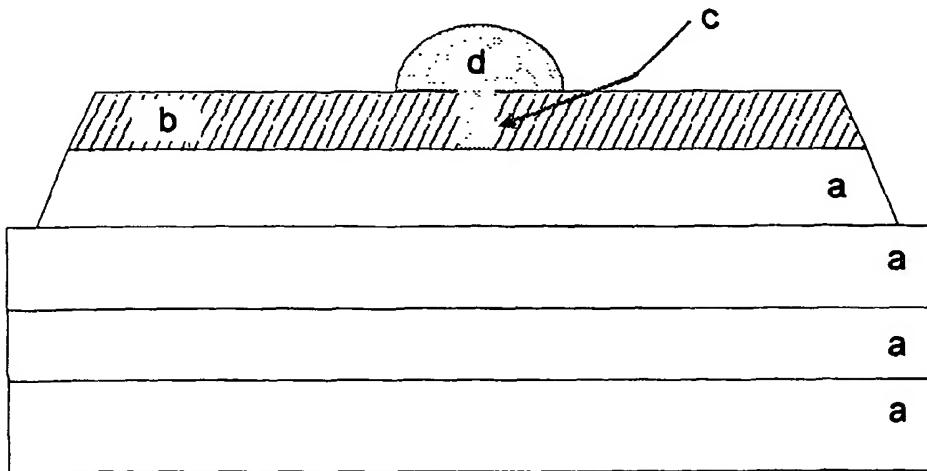
(74) Mandatario: REPRESA SÁNCHEZ, Domingo; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Oficina de Transferencia de Tecnología, C/Serrano, 113 - 2<sup>a</sup> planta, 28006 MADRID (ES).

(81) Estados designados (nacional): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,

[Continúa en la página siguiente]

(54) Title: MAGNETIC SENSOR BASED ON BALLISTIC MAGNETORESISTANCE USING A PINHOLE MULTILAYER SYSTEM

(54) Título: SENSOR MAGNETICO BASADO EN MAGNETORESISTENCIA BALISTICA MEDIANTE MULTICAPAS Y PINHOLES



(57) Abstract: The invention relates to method of producing magnetic sensors based on ballistic magnetoresistance using pinhole multilayer systems. The multilayers used can take the form of a combination of layers of materials having different conductive and magnetic properties. The pinholes employed for constriction purposes can be integrated into the multilayer system or incorporated later using different methods. The invention is characterised in that nanometric-sized electric contacts are produced between nanometric-sized systems: thin magnetic layers and clusters. According to the invention, BMRS sensors are provided with the necessary stability and stiffness for use in devices. Moreover, said invention can be used to produce sensors having a resistance and sensitivity desired in accordance with the application thereof.

[Continúa en la página siguiente]

WO 02/095434 A1



CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GI, GM, HR, IU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **Estados designados (regional):** patente ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), patente euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), patente europea (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), patente OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Publicada:**

— *con informe de búsqueda internacional*

Para códigos de dos letras y otras abreviaturas, véase la sección "Guidance Notes on Codes and Abbreviations" que aparece al principio de cada número regular de la Gaceta del PCT.

---

(57) **Resumen:** Se propone una configuración para la construcción de sensores magnéticos basados en la magnetoresistencia balística basada en el uso de sistemas de mult capas y defectos (pinholes). Las mult capas utilizadas puede ser una combinación de capas de materiales con distintas propiedades conductoras así como magnéticas. Los pinholes utilizados como con stricción pueden ser intrínsecos al sistema de mult capas o pueden ser inducidos a posteriori mediante diversos métodos. El resultado importante es que se realizan contactos eléctricos de tamaño nanométrico entre sistemas de tamaño nanométrico: clusters (agregados) y capas delgadas magnéticas. Esta configuración proporciona a los sensores BMRS la estabilidad y rígidez necesaria para su uso en dispositivos, así como la posibilidad de obtener una resistencia y sensibilidad deseada en función de la aplicación a la que éstos sean destinados.

## SENSOR MAGNETICO BASADO EN MAGNETORESISTENCIA BALISTICA MEDIANTE MULTICAPAS Y PINHOLES

### OBJETO DE LA INVENCION

5 La presente invención describe un método para crear contactos eléctricos de tamaño nanométrico estables y que presentan un alto valor de la magnetoresistencia (variación de la resistencia al paso de una corriente eléctrica que presenta un conductor eléctrico ante la aplicación de un campo magnético externo) ante campos magnéticos de baja intensidad.

10

### ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La necesidad de sensores de campo magnético de mayor sensibilidad, resolución y de mayor velocidad de respuesta ha dado lugar a un gran interés, científico y tecnológico, por sistemas que cambian el valor de su resistencia 15 eléctrica ante la presencia de campos magnéticos externos.

Existe una gran variedad de sistemas que presentan dicho efecto magnetoresistivo, y con un amplio espectro en los valores de respuesta.

Un gran avance en el desarrollo de sensores de campo magnético basados en la magnetoresistencia viene dado por el descubrimiento de la 20 *Magnetoresistencia Balística* (N. García, M. Muñoz and Y.-W. Zhao. *Magnetoresistance in excess of 200% in Ballistic Ni Nanocontacts at Room Temperature and 100 Oe.* "Physical Review Letters", Volume 82, number 14 pag 2923 (1999); **SENSOR MAGNETICO PRODUCIDO POR UNA CONSTRICCIÓN. Solicitud de Patente Española P9802091. Solicitud 25 internacional WO 00/22448.**). Dichos sistemas presentan valores de la magnetoresistencia de hasta un 300% a temperatura ambiente y campos magnéticos de 100 Oe. El único inconveniente de estos sistemas es la inestabilidad mecánica que presentan lo que los hace operativos a lo mas durante algunos minutos.

30 El problema de la estabilidad se mejoró mediante la producción de los nanocontactos mediante electroquímica (N. García, H. Rohrer, I. G. Savili and Y.-W. Zhao. *Negative and Positive Magnetoresistanc Manipulation in*

an Electr d posit d Nanometer Ni C ntact. "Physical Review Letters", Volume 85, number 14 pag 3053 (2000); Manipulacion de la magnetoresistencia mediante la aplicación de pulsos de corriente y campo magnético externo. Solicitud de patente española P200000411.)

5 Estos contactos son estables durante días, pero aun así están lejos de la estabilidad deseada en un dispositivo.

En la presente invención se presenta un método mediante el cual es posible la fabricación de contactos eléctricos de tamaño nanométrico, estables y con gran respuesta magnetoresistiva.

10

### **DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN**

Los sistemas magnetoresistivos basados en la magnetoresistencia balística (BMRS) anteriormente citados constan fundamentalmente de dos *reservoirs* magnéticos unidos por un contacto eléctrico de tamaño nanométrico 15 (fig. 1), de ser de dimensiones menores o similares a la de la longitud de onda del electrón.

Esta invención describe un sistema en el que es posible realizar dicho contacto entre dos *reservoirs* magnéticos que cumple los requisitos de tamaño y estabilidad deseada.

20 Se propone el uso de multicapas conductoras (a en fig. 2), recubiertas por una capa de material no conductor o aislante (b en fig. 2). El grosor de esta capa puede ser de unas dimensiones similares o menores a la longitud de onda del electrón. Dicha capa aislante tiene defectos (pinholes) en el sentido de que en determinado punto (c en fig. 2) (o puntos) dicha capa es conductora. Estos 25 defectos pueden ser intrínsecos a la forma de preparación de la capa aislante o pueden ser inducidos a posteriori.

30 Sobre este defecto se deposita (mediante evaporación de metal o electroquímicamente, por citar algunos de los posibles métodos) material conductor (d), de manera que es posible el hacer circular una corriente eléctrica entre las capas conductoras y este material depositado a través del defecto de la capa aislante. Las dimensiones del defecto de la capa aislante vienen determinado por las condiciones en las que se quiera utilizar el dispositivo, o por

la resistencia eléctrica que este haya de tener, pero en general se puede decir que han de ser tales que la conducción entre las mult capas y el material depositado sobre dicho defecto ha de ser balística.

Esta configuración tiene todos los elementos requeridos por un sensor

5 BMRS (los dos reservoirs y la con stricci ón) y proporciona una rigidez tal que el sistema es indefinidamente estable y por lo tanto se puede aplicar en cualquier tipo de dispositivo.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

10 **Figura 1:** Se muestra la configuración más sencilla así como los elementos necesarios de un sensor BMRS (sensor magnético basado en la magnetoresistencia balística). Estos elementos son dos reservoir magnéticos ( $R_M$ ) unidos por una con stricci ón (C) que puede ser magnética o no y de propiedades conductoras a determinar en función de la aplicación.

15 **Figura 2:** Esquema del sistema propuesto en la presente invención. En (a) se representan las mult capas que puede ser una única capa o varias de ellas. En caso de ser varias de ellas pueden ser conductoras, aislantes o semiconductoras o una combinación de ellas. Así mismo se puede combinar las propiedades magnéticas de estas capas utilizando capas de materiales 20 magnéticos blandos, materiales magnéticos duros o materiales no magnéticos. Mediante (b) se representa la capa que en principio se propone aislante pero podría utilizarse materiales semiconductores e incluso conductores. El defecto en esta capa viene representado por (c) y el material depositado a posteriori mediante (d).

25 **Figura 3:** Imagen obtenida mediante Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) del cluster (agregado) de material magnético depositado, mediante métodos electroquímicos, sobre la capa aislante en las muestras utilizadas para demostrar la viabilidad de la presente invención.

30 **Figura 4:** Resultados de las medidas realizadas en el Laboratorio de Física de Sistemas Pequeños y Nanotecnología en los que se pone de manifiesto la dependencia de la resistencia eléctrica del sistema aquí descrito en función del campo magnético aplicado.

### EJEMPLO DE REALIZACIÓN

En el Laboratorio de Física de Sistemas Pequeños y Nanotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se han realizado los experimentos previos que confirman la viabilidad del sistema anteriormente 5 descrito.

Las muestras utilizadas constan de un sistema de multicapas a continuación descrito: un substrato de silicio de forma que proporcione rigidez a la muestra; una capa de óxido térmico de silicio que aísla eléctricamente el substrato de silicio de las siguientes capas conductoras; una combinación de 10 capas de materiales conductores magnéticos y no magnéticos, estas capas hacen que la resistencia eléctrica de esta combinación de capas sea considerablemente menor que la resistencia del pinhole así como ayudan a determinar la magnetización de la capa inmediatamente anterior a la capa de óxido; finalmente una capa de níquel.

15 Sobre esta última capa de níquel se deposita una capa de aluminio. Se ha experimentado con distintos grosores de aluminio, variando desde unas décimas de nanómetros hasta varios nanómetros.

Todas las anteriores capas se depositan sobre el óxido de silicio en un sistema de ultra alto vacío lo que hace que éstas sean de gran pureza química. 20 Así mismo la orientación de la superficie del silicio y por tanto del óxido de silicio, es tal que las capas depositadas se pueden considerar perfectamente planas hasta niveles atómicos.

Una vez depositadas todas las capas anteriormente citadas se han seguido dos métodos para transformar la capa de aluminio en óxido de 25 aluminio. La primera es inyectar oxígeno en el sistema de ultra alto vacío, lo que permite controlar el nivel de oxidación del aluminio. Y la segunda, más rudimentaria pero igualmente funcional, es dejar el sistema expuesto al oxígeno atmosférico.

El siguiente punto es inducir los pinholes en la capa de óxido de 30 aluminio. Para ello se sumerge la muestra en un electrolito, habitualmente una disolución de sulfato de níquel. Se aplica un voltaje entre las capas

conductoras y un electrodo sumergido en la disolución. De esta forma, si los defectos existen en la capa de óxido de aluminio, los iones de níquel migran a los lugares que ocupan dichos defectos y se produce una electrodeposición de níquel en esos lugares. Se suele limitar la superficie del óxido de aluminio

5 expuesta al electrolito de manera que es posible controlar el numero de defectos (habitualmente uno).

Si dichos defectos no existen se pueden inducir aplicando un voltaje un poco mayor de forma que se produzca una ruptura eléctrica permanente. Se repite nuevamente el proceso anteriormente descrito y se deposita el níquel.

10 En ocasiones después de la deposición de níquel se cambia el electrolito por una disolución de sulfato de cobre para depositar ahora cobre sobre el níquel lo que previene de la oxidación de este ultimo.

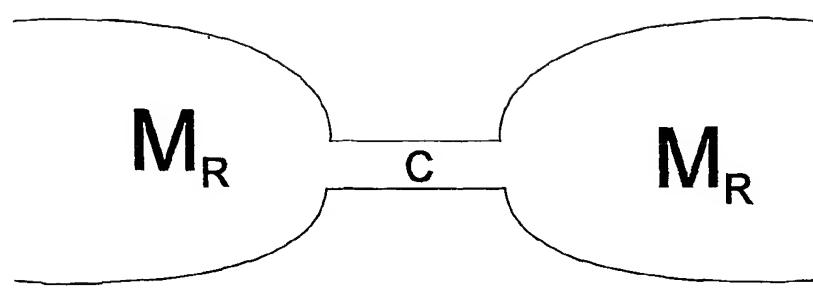
15 En la figura 4 se puede apreciar los resultados de los experimentos realizados en el laboratorio anteriormente mencionado. En la figura (a) se aprecia como existe una relajación de la resistencia eléctrica de la muestra así como una dependencia con el campo magnético aplicado. En la figura (b) se muestra la dependencia con el campo magnético tras normalizar los datos de la figura (a).

REIVINDICACIONES

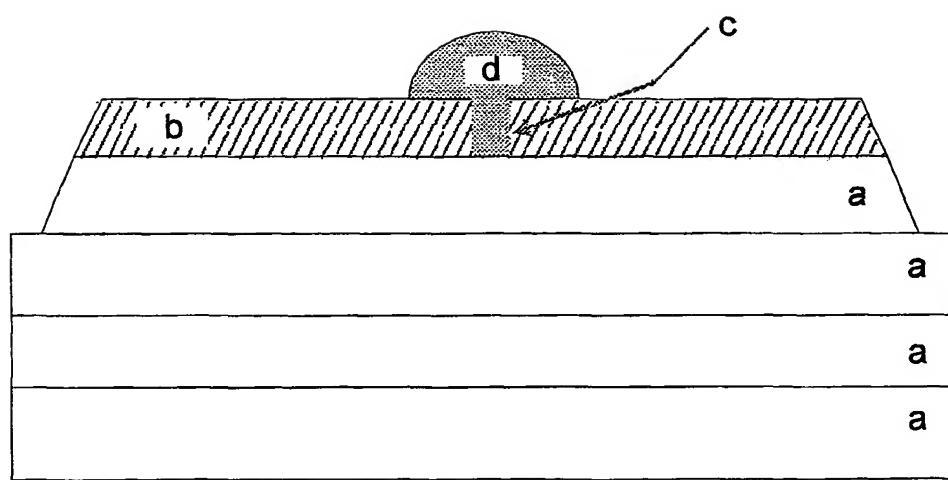
1. Se propone un método para realizar sensores magnetoresistivos basados en la magnetorresistencia balística caracterizado por el uso de multicapas conductoras eléctricas y magnéticas recubiertas por una capa de material aislante con defectos intrínsecos sobre los que se deposita material conductor magnético.  
5
2. Se propone un sensor basado en la reivindicación 1 de aplicación en cabezas de lectura-escritura en sistemas de almacenamiento magnético  
10
3. Un método basado en la reivindicación 1 en el que las multicapas es una combinación de capas conductoras no magnéticas, conductoras magnéticas, aislantes magnéticas, aislantes no magnéticas, semiconductoras magnéticas  
15 o no magnéticas, o una combinación de todas las anteriores.
4. Un método basado en las reivindicaciones 1 y 3 en la que la capa de material aislante tiene defectos intrínsecos o inducidos.  
20
5. Un método basado en las reivindicaciones 1, 3 y 4 en el que la capa de material aislante se sustituye por un material semiconductor.
6. Un método basado en las reivindicaciones 1, y reivindicaciones de 3 a 5 en el que los defectos en el semiconductor se inducen mediante la variación de la  
25 concentración del material dopante en el semiconductor.
7. Un método basado en las reivindicaciones 1 y reivindicaciones 3 a 6 en el que el material depositado es conductor, aislante, semiconductor, o una combinación de éstos.

8. Un método basado en las reivindicaciones 1 y reivindicaciones 3 a 7 en el que el material depositado es magnético o no magnético o una combinación de los anteriores.
- 5 9. Un método basado en la reivindicación 1 y reivindicaciones 1 a 8 en el que el material depositado se deposita por métodos electroquímicos.
- 10 10. Un método basado en la reivindicación 1 y reivindicaciones 3 a 8 en el que el material depositado es una partícula o conglomerado de partículas, magnéticas o no magnéticas, conductoras, aislantes o semiconductoras o una combinación de las anteriores.
- 15 11. Un método basado en la reivindicación 1 y reivindicaciones 3 a 10 en el que el material depositado se deposita mediante técnicas de evaporación de metales.

1/4

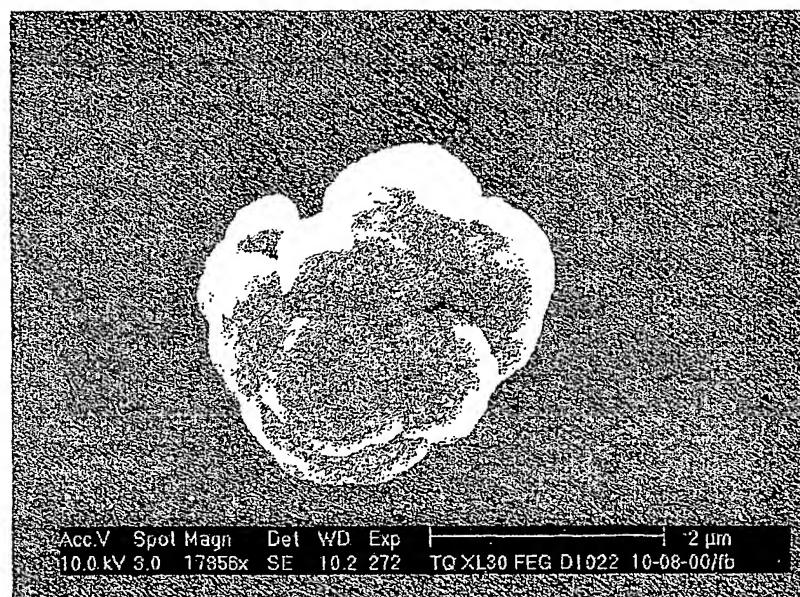


**Figura 1**



**Figura 2**

3/4



**Figura 3**

4/4

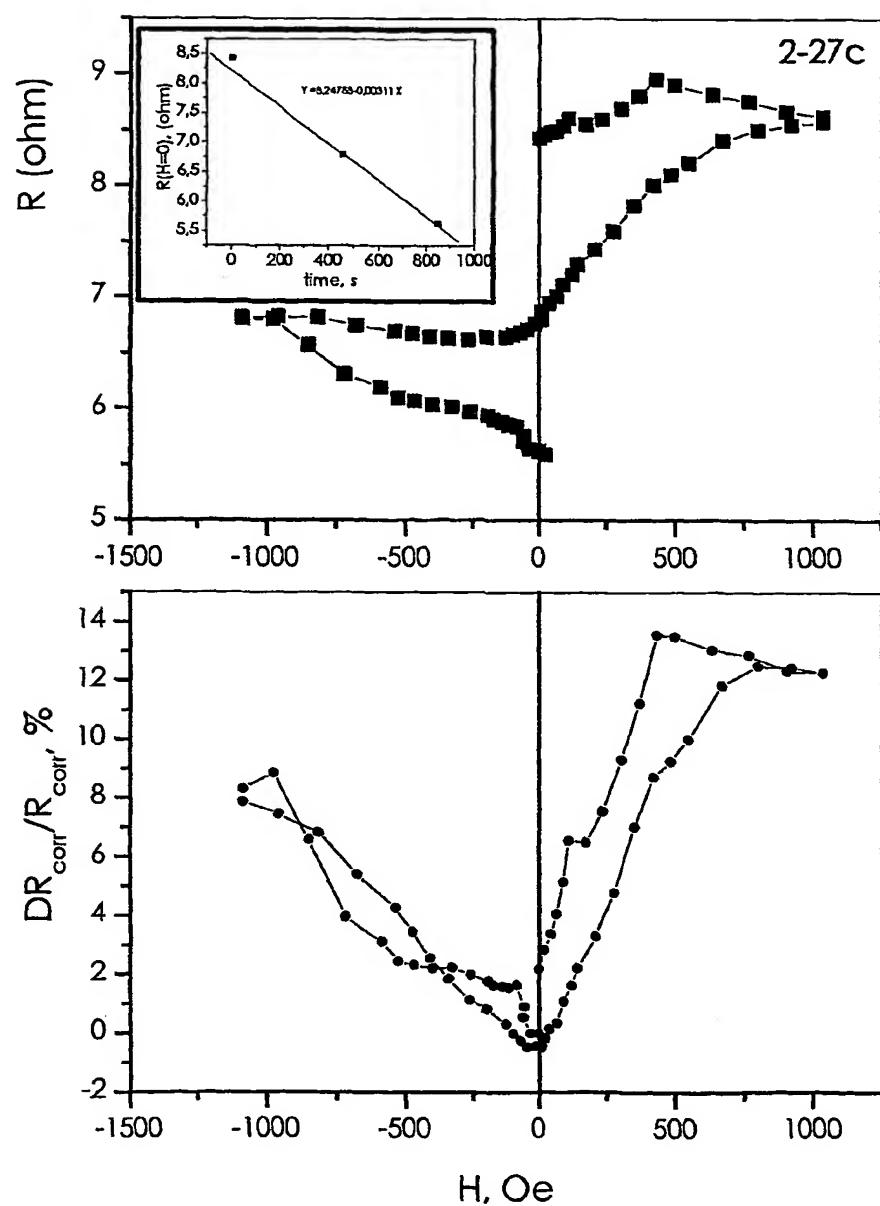


Figura 4

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/ES/02/00222

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

**CIP<sup>7</sup> G01R 33/09**

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

**CIP<sup>7</sup> G01R 33/09**

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

**EPODOC, WPI, PAJ, OEPMPAT**

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	MUÑOZ et al. "Ballistic magnetoresistance in a nanocontact between a Ni cluster and a magnetic thin film" 29.10.2001. Applied Physics Letters, American Institute of Physics. Vol. 79, n° 18, pages 2946-2948	1-4, 7-10
X	WO 9747982 A (PHILIPS) 18.12.1997, pages 1, lines 1-8; page 4, lines 30- page 5, line 2; pages 9; drawings 4-6	1-4, 7-11 5,6
Y	US 6011674 A (NAKATANI et al.) 04.01.2000, abstract	5,6
A	GARCIA. "Conducting ballistic magnetoresistance and tunneling magnetoresistance: Pinholes and tunnel barriers" 28.08.2000.. Applied Physics Letters, American Institute of Physics. Vol. 77, n° 9, pages 1351-1353	1,4,7,8,9

Further documents are listed in the continuation of Box C.  See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "B" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
**23 August 2002**

Date of mailing of the international search report  
**2 September 2002 02.09.2002**

Name and mailing address of the ISA/ O.E.P.M.

Authorized officer **JAVIER OLALDE SÁNCHEZ**

C/Panamá 1, 28071 Madrid, España.  
Facsimile No. n° de fax +34 91 3495304

Telephone No. + 34 91 3495496

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**  
Information on patent family members

International Application No

PCT/ES/00222

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9747982 A	18.12.1997	JP 11510911 T EP 0843827 A US 5936402 A	21.09.1999 27.05.1998 10.08.1999
US 6011674 A	04.01.2000	US 2002018325 A US 6278593 B US 5726837 A US 5390061 A JP 4123306 A JP 4103014 A JP 4103013 A JP 4042417 A	14.02.2002 21.08.2001 10.03.1998 14.02.1995 23.04.1992 06.04.1992 06.04.1992 13.02.1992

# INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional nº  
PCT/ES/02/00222

## A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

**CIP<sup>7</sup> G01R 33/09**

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y la CIP.

## B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima consultada (sistema de clasificación, seguido de los símbolos de clasificación)

**CIP<sup>7</sup> G01R 33/09**

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)

**EPODOC, WPI, PAJ, OEPMPAT**

## C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría*	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones
P,X	MUÑOZ et al. "Ballistic magnetoresistance in a nanocontact between a Ni cluster and a magnetic thin film" 29.10.2001. Applied Physics Letters, American Institute of Physics. Vol. 79, nº 18, páginas 2946-2948	1-4, 7-10
X	WO 9747982 A (PHILIPS) 18.12.1997, página 1, líneas 1-8; página 4, línea 30-página 5, línea 12; página 9; figuras 4-6	1-4, 7-11
Y	US 6011674 A (NAKATANI et al.) 04.01.2000, resumen	5,6
Y	US 6011674 A (NAKATANI et al.) 04.01.2000, resumen	5,6
A	GARCIA. "Conducting ballistic magnetoresistance and tunneling magnetoresistance: Pinholes and tunnel barriers" 28.08.2000. Applied Physics Letters, American Institute of Physics. Vol. 77, nº 9, páginas 1351-1353	1,4,7,8,9

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos

Los documentos de familia de patentes se indican en el anexo

\* Categorías especiales de documentos citados:

"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.

"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.

"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la indicada).

"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.

"P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.

"T" documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad que no pertenece al estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la comprensión del principio o teoría que constituye la base de la invención.

"X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.

"Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

"&" documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional: 23 de agosto de 2002

Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional

02 SEP 2002

02.09.02

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional O.E.P.M.

Funcionario autorizado: JAVIER OLALDE SÁNCHEZ

C/Panamá 1, 28071 Madrid, España.  
nº de fax +34 91 3495304

nº de teléfono + 34 91 3495496

**INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL**

Información relativa a miembros de familias de patentes

Solicitud interna n°

PCT/ES/02/00222

Documento de patente citado en el informe de búsqueda	Fecha de publicación	Miembro(s) de la familia de patentes	Fecha de publicación
WO 9747982 A	18.12.1997	JP 11510911 T EP 0843827 A US 5936402 A	21.09.1999 27.05.1998 10.08.1999
US 6011674 A	04.01.2000	US 2002018325 A US 6278593 B US 5726837 A US 5390061 A JP 4123306 A JP 4103014 A JP 4103013 A JP 4042417 A	14.02.2002 21.08.2001 10.03.1998 14.02.1995 23.04.1992 06.04.1992 06.04.1992 13.02.1992

Machine Translation of WO 02/095434

SENSOR BASED MAGNETIC IN MAGNETORESISTENCIA BALLISTICS [BY MEANS OF] [MULTICAPAS] AND PINHOLES OBJECT OF THE INVENTION

The present invention describes a method to create electric contacts of size stable nanométrico and that they present a high value of the magnetoresistencia (variation of the resistance to the step of one electric current that an electric driver presents before the application of a magnetic field external) before magnetic fields of low intensity.

ANTECEDENTS OF THE INVENTION

The necessity of sensors of magnetic field of bigger sensibility, resolution and of more answer speed he/she has given place to a great one [Interest,] [Scientific] and [Technological,] for systems that change the value of their electric resistance before the presence of magnetic fields [EXTERNAL.]

A great variety of systems that you/they present this effect magnetoresistivo, exists and with a wide one spectrum in the answer values.

A great advance in the development of sensors of magnetic field based on the magnetoresistencia he/she comes given by the discovery of the [MAGNETORESISTENCIA] Ballistics (N. GARCÍA, M. MUÑOZ AND [Y. -W.] ZHAO.

Magnetoresistance in excess of 200% in Ballistic Neither Nanocontacts at Room Temperature and 100 [OE. PHYSICAL] REVIEW LETTERS", VOLUME 82, NUMBER 14 PAG 2923 (1999); SENSOR PRODUCED MAGNETIC FOR A [CONSTRICCIÓN.] Application of Spanish Patent [P9802091.] international Application WO 00/22448.). This systems present values of the magnetoresistencia of until a [300%] to [TEMPERATURE] it sets and magnetic fields of 100 Oe. The only inconvenience of these systems is the mechanical uncertainty that you/they present the that he/she makes them operative to him but during [SOME] minutes.

The problem of the stability you improves by means of the [Production] of the nanocontactos by means of electrochemistry (N. [GARCÍA,] H. Rohrer, [1.] G. [SAVELIEV] and [Y. -W.] ZHAO. Negative and Positive Magnetoresistance Manipulation in an Electrodeposited NANOMETER [NEITHER CONTACT. PHYSICAL REVIEW LETTERS",] VOLUME 85, NUMBER 14 pag 3053 [(2000); MANIPULATION] of the magnetoresistencia by means of the application of current pulses and external magnetic field. Application of Spanish patent [P200000411.]) These contacts are stable during [Days,] but even so they are far of the [STABILITY] wanted in a device.

In the present invention a method is presented by means of [THE ONE WHICH] it is possible the production of contacts [Electric]

of size nanométrico, stable and with great answer magnetoresistiva.

#### [DESCRIPTION] OF THE INVENTION

The systems magnetoresistivos based on the ballistic magnetoresistencia (BMRS) previously [MENTIONED] they consist fundamentally of two magnetic reservoirs united by an electric contact of size nanométrico (fig. [1],) of smaller or more similar being of dimensions to that of the wave longitude of [Electron.]

This invention describes a system in the what an one it is possible to carry out this contact between two reservoirs magnetic that [it COMPLETES THE REQUIREMENTS] of size and wanted stability.

He/she intends the use of multicapas drivers (to in fig. 2), not recovered by a material layer driver or insulating (b in fig. 2). The grosor of this layer can be of some similar dimensions or smaller to the longitude of wave of the electron. This insulating layer has defects (pinholes) in the one sense that in certain point  $\circ$  in fig. 2) (or points) this layer is a driver. These defects can be [Intrinsic] to the form of preparation of the insulating layer or they can to be induced to posteriori.

On this defect it is deposited (by means of metal evaporation or [ELECTROQUÍMICAMENTE,] to mention some of the possible methods) conductive material (d), so that it is possible [MAKING CIRCULATE] an electric current among those you castrate drivers and this material deposited through defect of the insulating layer. Those dimensions of defect of the insulating layer come determined by the conditions in those that you want to use the device, or for the electric resistance that this he/she must have, but in general you he/she can [to SAY] that must be such that the conduction between the multicapas and the material deposited on this defect it must be ballistic.

This configuration has all the elements required by a sensor BMRS (the two reservoirs and the constriction) and [it PROVIDES] a such rigidity that the system is indefinitely stable and therefore one can [to APPLY] in any device type.

#### [DESCRIPTION] OF THE FIGURES

Figure 1: the simplest configuration is shown this way as those [NECESSARY ELEMENTS] of a sensor BMRS (magnetic sensor based on the ballistic magnetoresistencia). These [ELEMENTS] they are two magnetic reservoir (RM) united for a [Constriction] (C) that can be magnetic or not and of properties drivers to to determine in function of [THE Application.]

It figures 2: system Outline proposed in the present invention. In [(TO)] those are represented [MULTICAPAS] that can be an only

layer or several of them. In the event of being several of them they can be drivers, ailantes or semiconductors or a combination of them. [This way] same you it can combine the magnetic properties of these layers [USING] you castrate of soft magnetic materials, hard magnetic materials or non magnetic materials.

By means of (b) the layer is represented that in [I BEGIN] he/she intends insulating but [It would rot] to be used material semiconductors and [EVEN] drivers. The defect in this layer comes represented for (c) and the material deposited to posteriori by means of (d).

It figures 3: [IMAGE] obtained by means of Electronic Microscope of Sweeping (SEM) of the cluster (attaché) of deposited magnetic material, by means of methods [ELECTROQUÍMICOS,] on the insulating layer in the samples [USED] to demonstrate the [VIABILITY] of the present invention.

It figures 4: Results of the measures carried out in the Laboratory of [Physics] of Systems Small and Nanotecnología in those that he/she shows the dependence of the resistance electric of the system here described in function of the applied magnetic field.

EXAMPLE OF REALIZATION In the Laboratory of Physics of Small Systems and [NANOTECNOLOGÍA] of Superior Council of [INVESTIGATIONS] Scientific they are had [CARRIED OUT] the previous experiments that confirm the viability of the system previously described.

The used samples consist next of a multicapas system described: a substratum of silicon so that it provides rigidity to the sample [; A] it castrates of I oxidize thermal of [SILICON] that aísla [Electrically THE] substratum of silicon of the following layers drivers; a combination of layers of magnetic and not magnetic conductive materials, these layers make that the electric resistance of this combination of layers is [CONSIDERABLY] smaller than the resistance of the [PINHOLE] as well as they help to to determine the [MAGNETIZACIÓN] of the layer immediately previous to the oxide layer; finally a nickel layer.

On this it finishes layer of [Nickel] an aluminum layer is deposited. It has been experienced with different aluminum grosores, varying from some tenth of [NANÓMETROS] until several [NANÓMETROS.]

All the previous layers are deposited on [THE oxide] of [SILICON] in a system of ultra high hole that makes that these are of great purity [Chemistry.]

Likewise [THE Orientation] of [THE SURFACE OF THE SILICON] and therefore of I oxidize of [SILICON,] it is such that the

deposited layers can be considered perfectly plane until levels [Atomic.] :

Once deposited all the previously mentioned layers are had [FOLLOWED] two methods for [to TRANSFORM] the aluminum layer in I oxidize of aluminum. The first one is to inject I oxygenate in the system of ultra high [I Empty,] what allows to control the level of oxidation of the one aluminum. And the second, more rudimentary but [EQUALLY] [FUNCTIONAL,] it is to leave the one exposed system to the I oxygenate atmospheric.

[THE] [FOLLOWING] point is [to INDUCE] those [PINHOLES] in the layer of I oxidize of aluminum. For he/she dives it the sample in an electrolyte, habitually a breakup of sulfate of nickel. A voltage is applied among the layers drivers and an electrode submerged in the breakup. This way, if the defects exist in the layer of I oxidize of aluminum, the ions of [Nickel] migran to the places that occupy this defects and one takes place [ELECTRODEPOSICIÓN] of [Nickel] in those places. You [it usually LIMITS THE] surface of I oxidize of aluminum exposed to the electrolyte so that it is possible to control the I number of defects (habitually one).

If this defects don't exist they can be induced [APPLYING] a voltage a little bigger than it forms that you [he/she TAKES PLACE] a permanent electric rupture. He/she repeats the process again previously described and the nickel is deposited.

In occasions after the deposition of [Nickel] the electrolyte is changed by a breakup of copper sulfate to deposit copper now on the [Nickel] what prevents of the [Oxidation] of this I finish.

In the figure 4 you can appreciate the results of the experiments [CARRIED OUT] in the one previously mentioned laboratory. In the figure (a) it is appreciated like a relaxation of the exists electric resistance of the sample as well as a dependence with the applied magnetic field. In the figure (b) the dependence is shown with the magnetic field after normalizing the data of the it figures (a).

CLAIMS 1. He/she intends a method for [to CARRY OUT] sensors [MAGNETORESISTIVOS] based on the ballistic magnetoresistencia characterized by the use of multicapas electric and magnetic drivers recovered by a layer of insulating material with intrinsic defects on those that magnetic conductive material is deposited.

2. He/she intends a sensor based on the recovery 1 of application in heads of [READING-WRITING] in systems of [STORAGE] magnetic 3. A method based on the recovery 1 in the one that those [MULTICAPAS] it is a combination of layers non magnetic drivers,

magnetic drivers, magnetic, insulating ailantes not magnetic, magnetic or not magnetic semiconductoras, or a combination of all the previous ones.

4. A method based on the recoveries 1 and 3 in which the layer of insulating material has defects [Intrinsic] or induced.

5. A method based on the recoveries 1, 3 and 4 in the one that the layer of insulating material you it substitutes for a material semiconductor.

6. A method based on the recoveries 1, and recoveries from 3 to 5 in the one that the defects in the semiconductor they are induced by means of the variation of the [Concentration] of the material dopante in the semiconductor.

7. A method based on the recoveries 1 and recoveries 3 at 6 in the one that the material deposited it is conductive, insulating, semiconductor, or a combination of these. 8. A method based on the recoveries 1 and recoveries 3 at 7 in the one that the deposited material is magnetic or not magnetic or a combination of the previous ones.

9. A method based on the recovery 1 and recoveries 1 at 8 in the one that the material deposited it is deposited by electrochemical methods.

10. A method based on the recovery 1 and recoveries 3 at 8 in the one that the material deposited it is a particle or conglomerate of particles, magnetic or not magnetic, drivers, ailantes or [SEMICONDUCTORAS] or a combination of the previous ones.

11. A method based on the recovery 1 and recoveries 3 at 10 in the one that the material deposited it is deposited by means of technical of evaporation of [METALS.]